

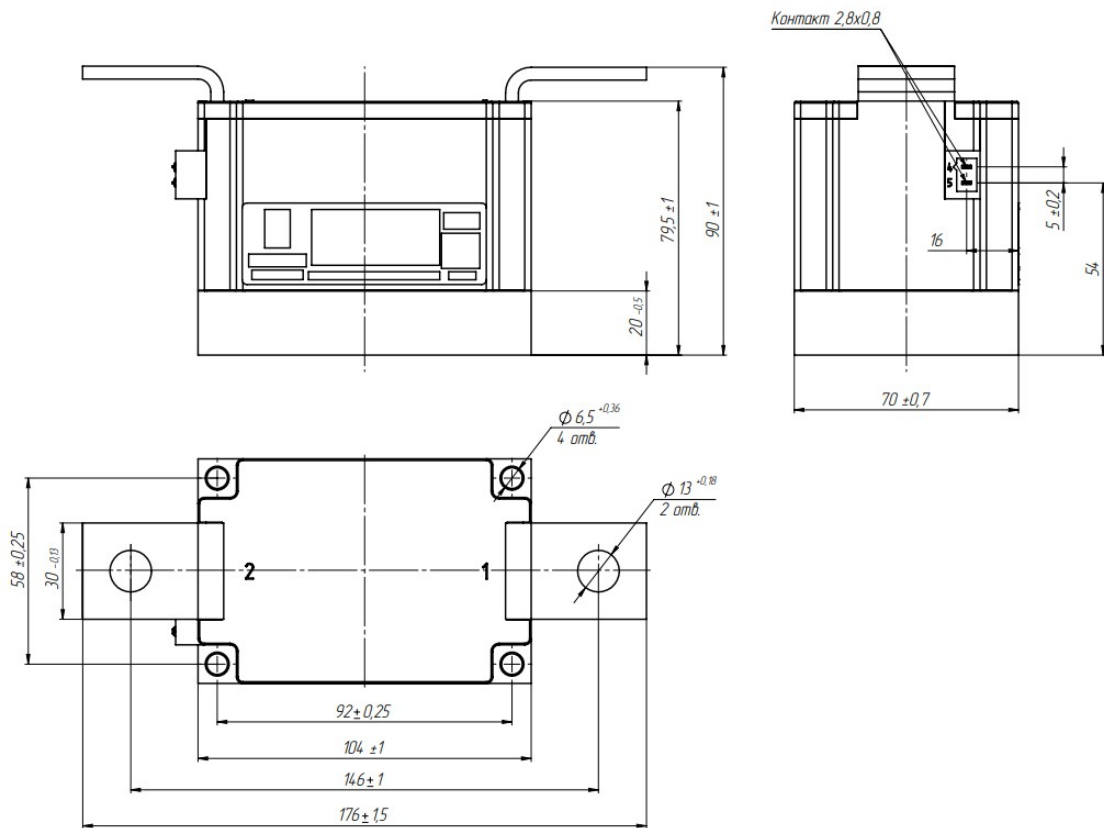
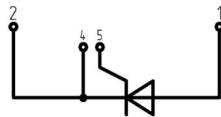


Изолированное основание  
Корпус промышленного стандарта  
Упрощенная механическая конструкция,  
быстрая сборка  
Прижимная конструкция

## Однопозиционный Тиристорный Модуль MT1-800-18-E

Средний прямой ток	$I_{TAV}$		800 A					
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$		1000...1800 В					
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$							
Время выключения	$t_q$		250 мкс					
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800
Класс по напряжению	10	11	12	13	14	15	16	18
$T_j, ^\circ C$	-40...+130							

**MT1**



**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ**

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
$I_{TAV}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	A	800 901	$T_c = 91\text{ }^\circ\text{C};$ $T_c = 85\text{ }^\circ\text{C};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	A	1256	$T_c = 91\text{ }^\circ\text{C};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	42.0 48.0	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			44.0 51.0	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
$I^2t$	Защитный показатель	$A^2c \cdot 10^3$	8800 11500	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			8000 10700	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
<b>Блокирующие параметры</b>					
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	1000...1800	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто	
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	1100...1900	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто	
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	B	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max};$ управление разомкнуто	
<b>Параметры управления</b>					
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	A	8	$T_j = T_{j\max}$	
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	B	5		
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	4	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления	
<b>Параметры переключения</b>					
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f = 1\text{ Hz}$ )	A/мкс	630	$T_j = T_{j\max}; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 2200\text{ А};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; U_G = 20\text{ В};$ $t_{GP} = 50\text{ мкс}; di_G/dt = 2\text{ А/мкс}$	
<b>Тепловые параметры</b>					
$T_{stg}$	Температура хранения	$^\circ\text{C}$	-40...+50		
$T_j$	Температура р-п перехода	$^\circ\text{C}$	-40...+130		
$T_{c\text{ op}}$	Рабочая температура корпуса	$^\circ\text{C}$	-40...+125		
<b>Механические параметры</b>					
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50		

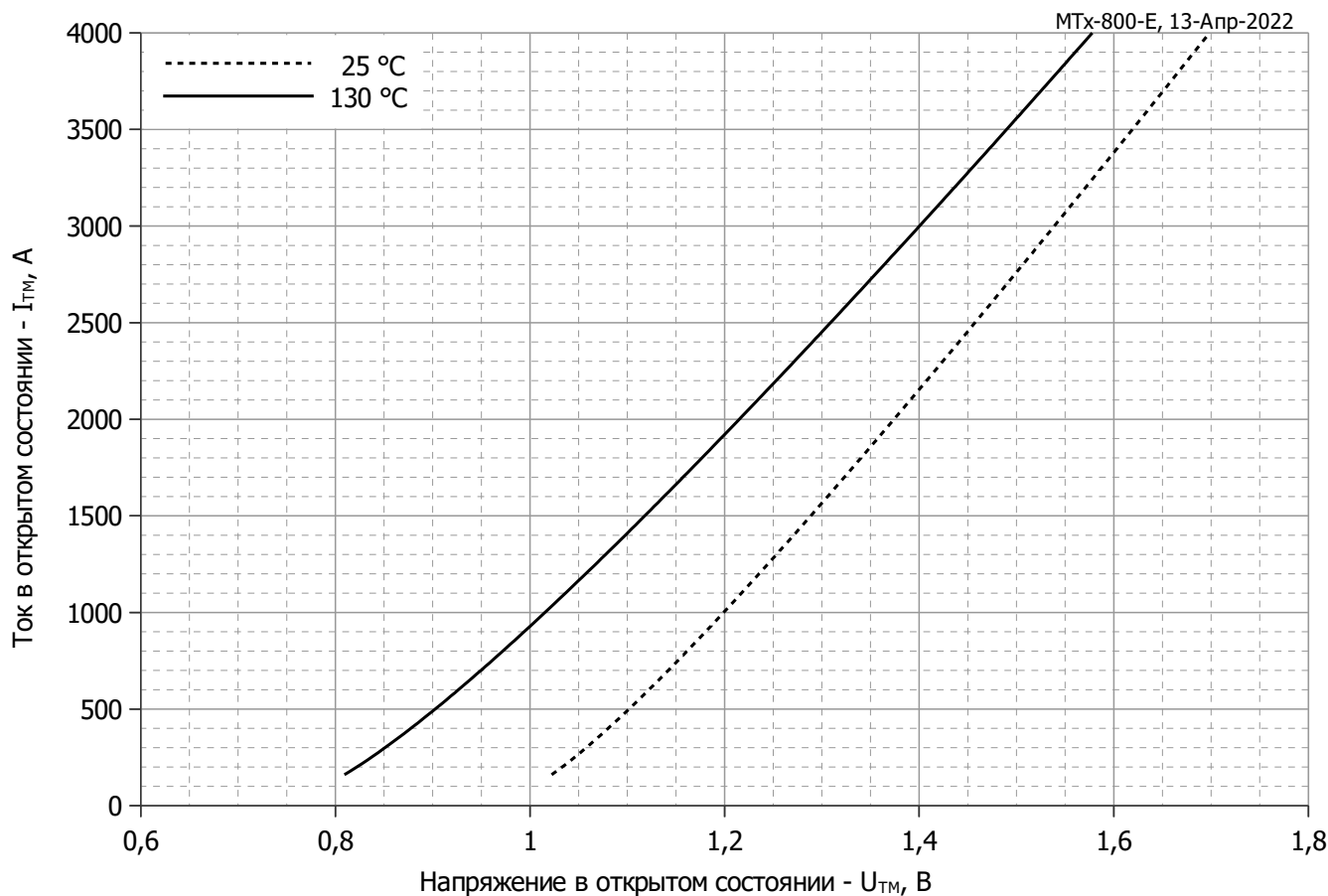
## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>					
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.45	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; I_{TM}=2500\text{ A}$	
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.834	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $0.5\pi I_{TAV} < I_T < 1.5\pi I_{TAV}$	
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.187		
$I_L$	Ток включения, макс	мА	1500	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; U_D=12\text{ В};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ A};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt\geq 1\text{ А/мкс}$	
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C};$ $U_D=12\text{ В};$ управление разомкнуто	
<b>Блокирующие характеристики</b>					
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	150 4.00	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	$U_D=U_{DRM}; U_R=U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67\cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто	
<b>Характеристики управления</b>					
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 2.50 1.50	$T_j=T_{j\text{ min}}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j=T_{j\text{ max}}$	$U_D=12\text{ В}; I_D=3\text{ А};$ Постоянный ток управления
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 150	$T_j=T_{j\text{ min}}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j=T_{j\text{ max}}$	
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.50	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67\cdot U_{DRM};$ Постоянный ток управления	
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	80.00		
<b>Динамические характеристики</b>					
$t_{gd}$	Время задержки, макс	мкс	0.90	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; U_D=1000\text{ В}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di/dt=200\text{ А/мкс};$	
$t_{gt}$	Время включения, макс	мкс	2.00	Импульс управления: $I_G=2\text{ А}; U_G=20\text{ В};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt=2\text{ А/мкс}$	
$t_q$	Время выключения <sup>2)</sup> , макс	мкс	250	$du_D/dt=50\text{ В/мкс}; T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс}; U_R=100\text{ В};$ $U_D=0.67\cdot U_{DRM}$	
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	3140	$T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс};$ $U_R=100\text{ В}$	
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, макс	мкс	33		
$I_{rr}$	Обратный ток восстановления, макс	А	190		
<b>Тепловые характеристики</b>					
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц	
		на модуль	$^\circ\text{C/Вт}$		
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс				
		на модуль	$^\circ\text{C/Вт}$		
<b>Характеристики изоляции</b>					
$U_{ISOL}$	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	$t=60\text{ с}$
			3.60		$t=1\text{ с}$

Механические характеристики				
M <sub>1</sub>	Момент затяжки основания (M6) <sup>3)</sup>	Нм	6.00	Допуск ± 15%
M <sub>2</sub>	Момент затяжки выводов (M12) <sup>3)</sup>	Нм	18.00	Допуск ± 15%
m	Масса, макс	г	2750	

МАРКИРОВКА	ПРИМЕЧАНИЕ																																														
<table border="1"> <tr> <td>MT</td><td>1</td><td>-</td><td>800</td><td>-</td><td>18</td><td>-</td><td>A2</td><td>M2</td><td>-</td><td>E</td><td>-</td><td>Y2</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>1. MT - Тиристорный модуль  2. Схема включения  3. Средний прямой ток, А  4. Класс по напряжению  5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии  6. Группа по времени выключения (du<sub>D</sub>/dt=50 В/мкс)  7. Тип корпуса (M.E)  8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: Y2</p>	MT	1	-	800	-	18	-	A2	M2	-	E	-	Y2	1	2	3	4	5	6	7	8						<p>1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P2</th> <th>K2</th> <th>E2</th> <th>A2</th> <th>T1</th> <th>P1</th> <th>M1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(du<sub>D</sub>/dt)<sub>crit</sub>, В/мкс</td> <td>200</td> <td>320</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>1600</td> <td>2000</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Время выключения (du<sub>D</sub>/dt=50 В/мкс)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t<sub>q</sub>, мкс</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Резьба должна быть смазана</p>	Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1	(du <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500	Обозначение группы	M2	t <sub>q</sub> , мкс	250
MT	1	-	800	-	18	-	A2	M2	-	E	-	Y2																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																								
Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1																																								
(du <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500																																								
Обозначение группы	M2																																														
t <sub>q</sub> , мкс	250																																														

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.



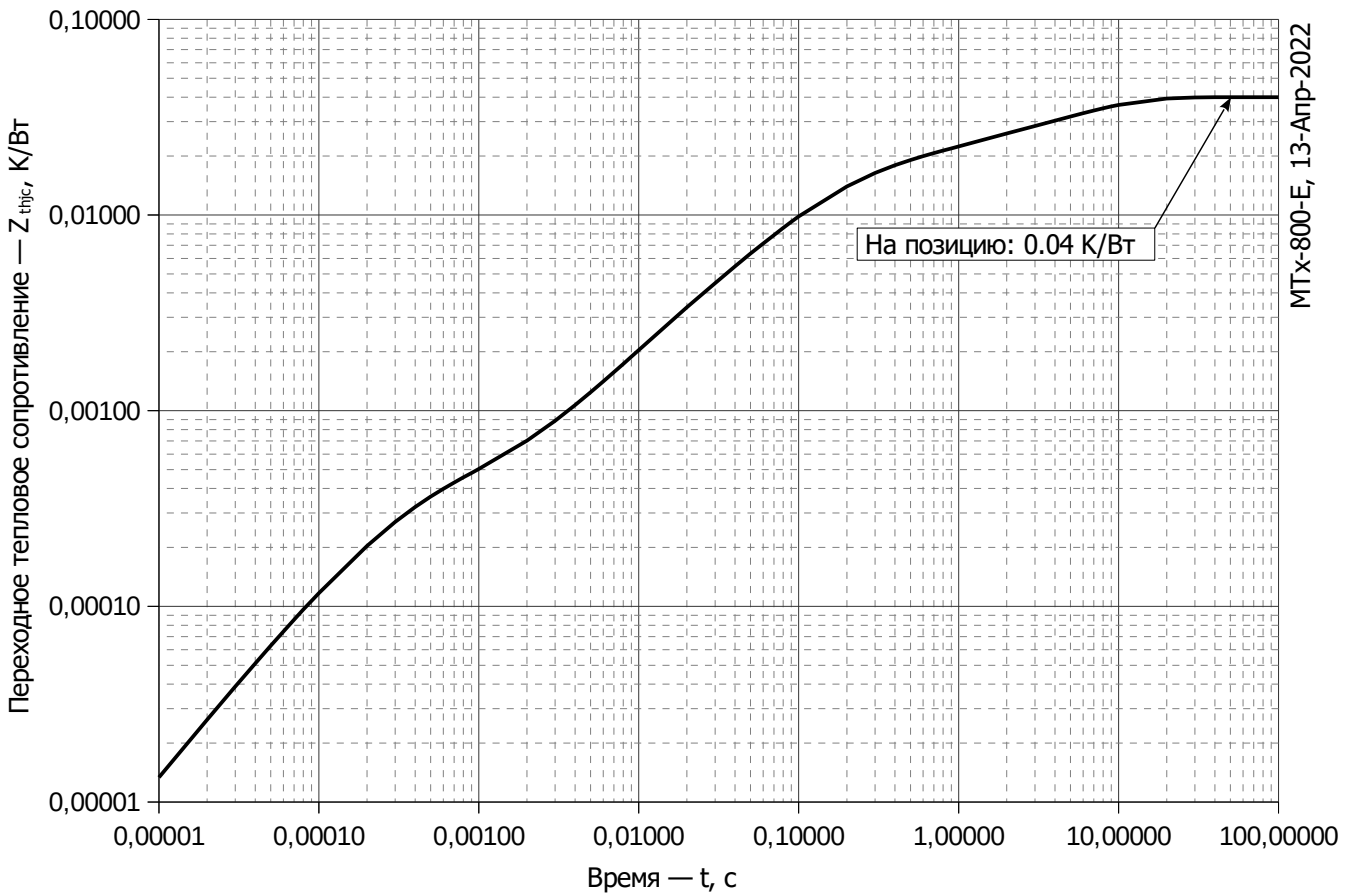
**Рис. 1 – Предельная вольт – амперная характеристика**

Аналитическая функция предельной вольт — амперной характеристики:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Коэффициенты для графика	
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = T_{j\text{max}}$
<b>A</b>	0.93815531	0.72539983
<b>B</b>	0.00013321	0.00013743
<b>C</b>	0.00505674	0.00041170
<b>D</b>	0.00293182	0.00473380

**Модель предельной вольт – амперной характеристики (см. Рис. 1).**



**Рис. 2 – Зависимость переходного теплового сопротивления  $Z_{thjc}$  от времени  $t$**

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где  $i = 1$  до  $n$ ,  $n$  – число суммирующихся элементов.

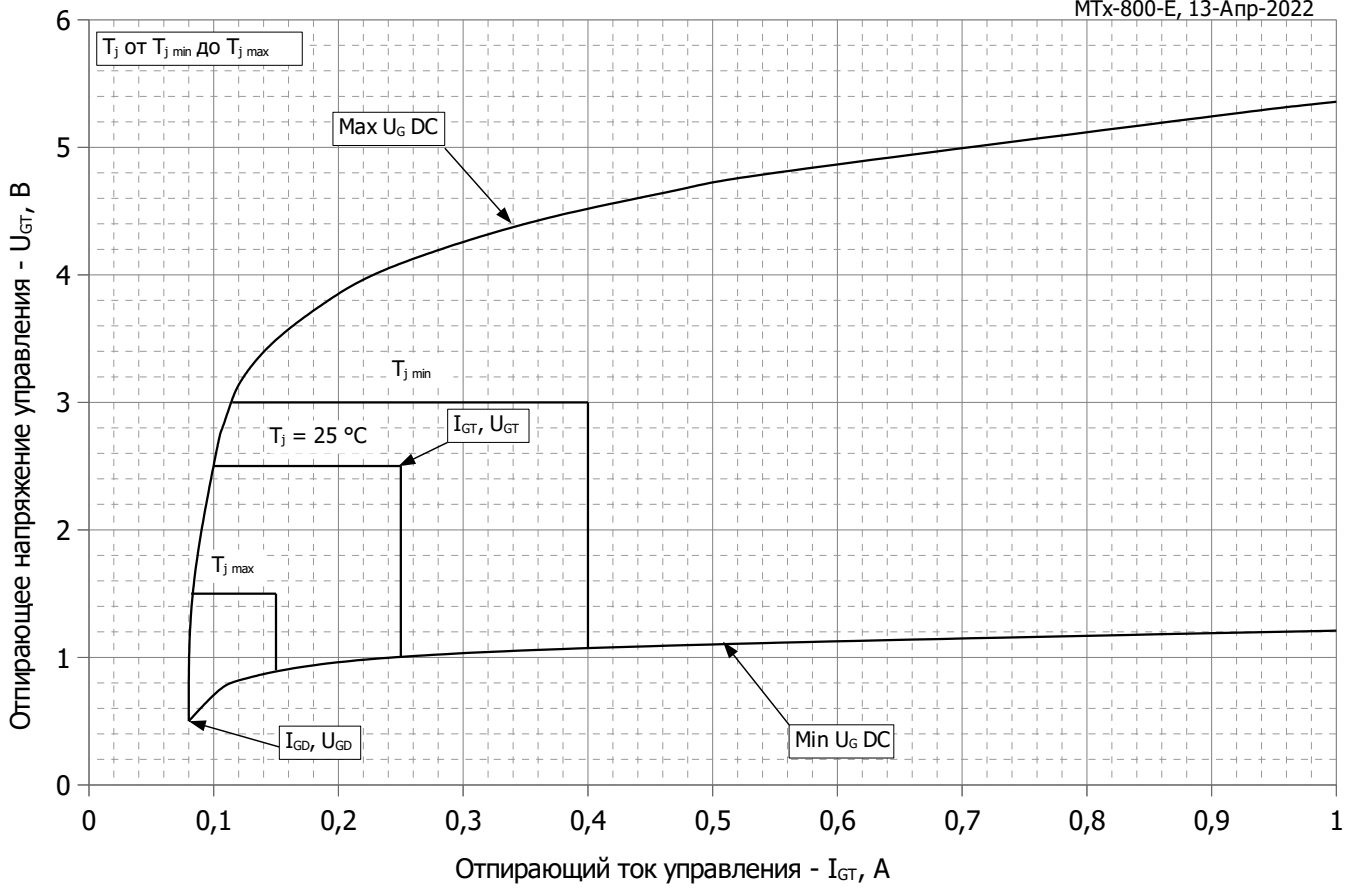
$t$  = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

$Z_{thjc}$  = Тепловое сопротивление за время  $t$ .

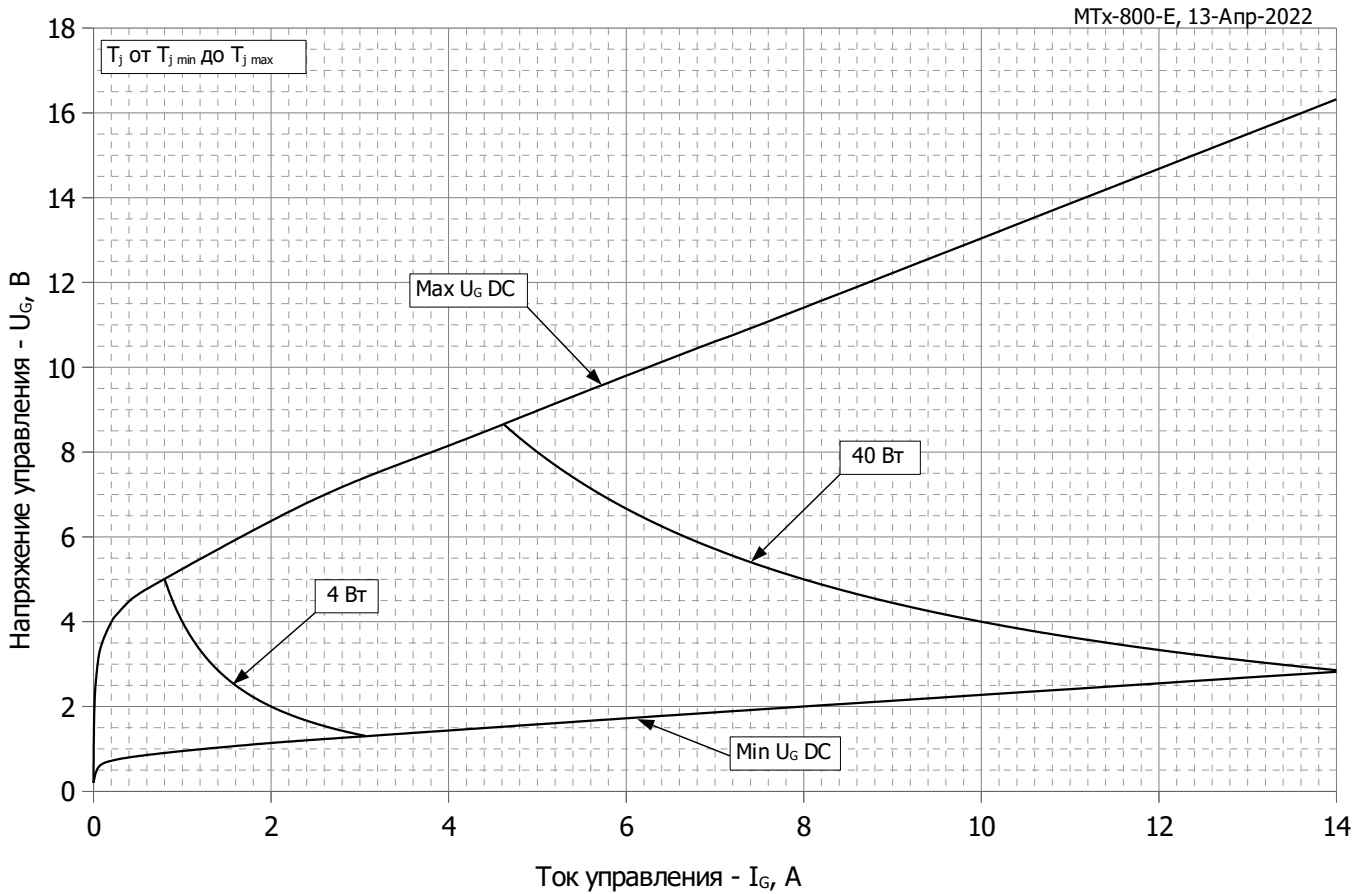
$R_i, \tau_i$  = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице

$i$	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.02251	0.005931	0.009502	0.004252	0.001006	0.0003132
$\tau_i, s$	5.887	0.7389	0.1616	0.08215	0.01267	0.0002712

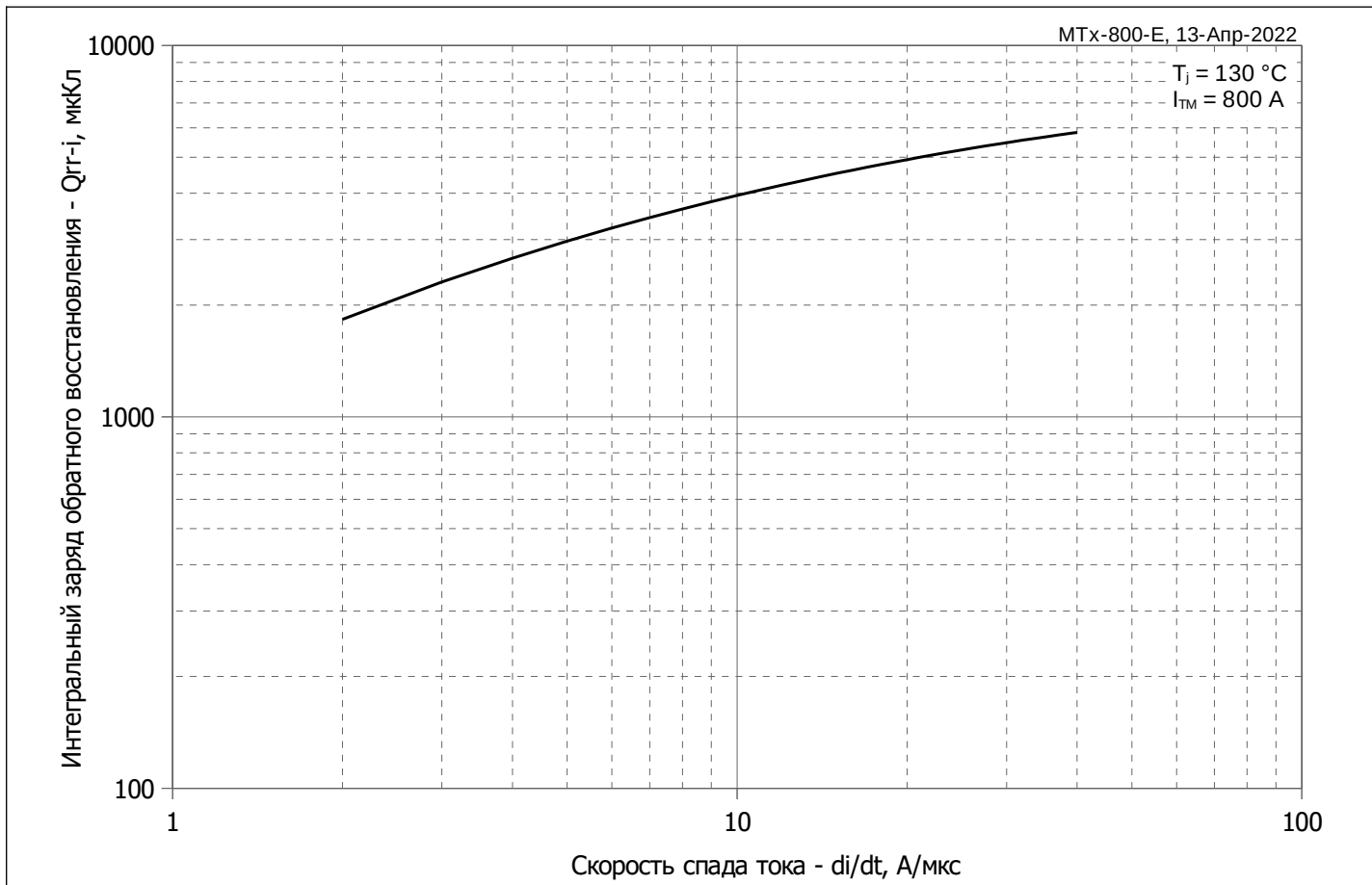
**Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 2)**



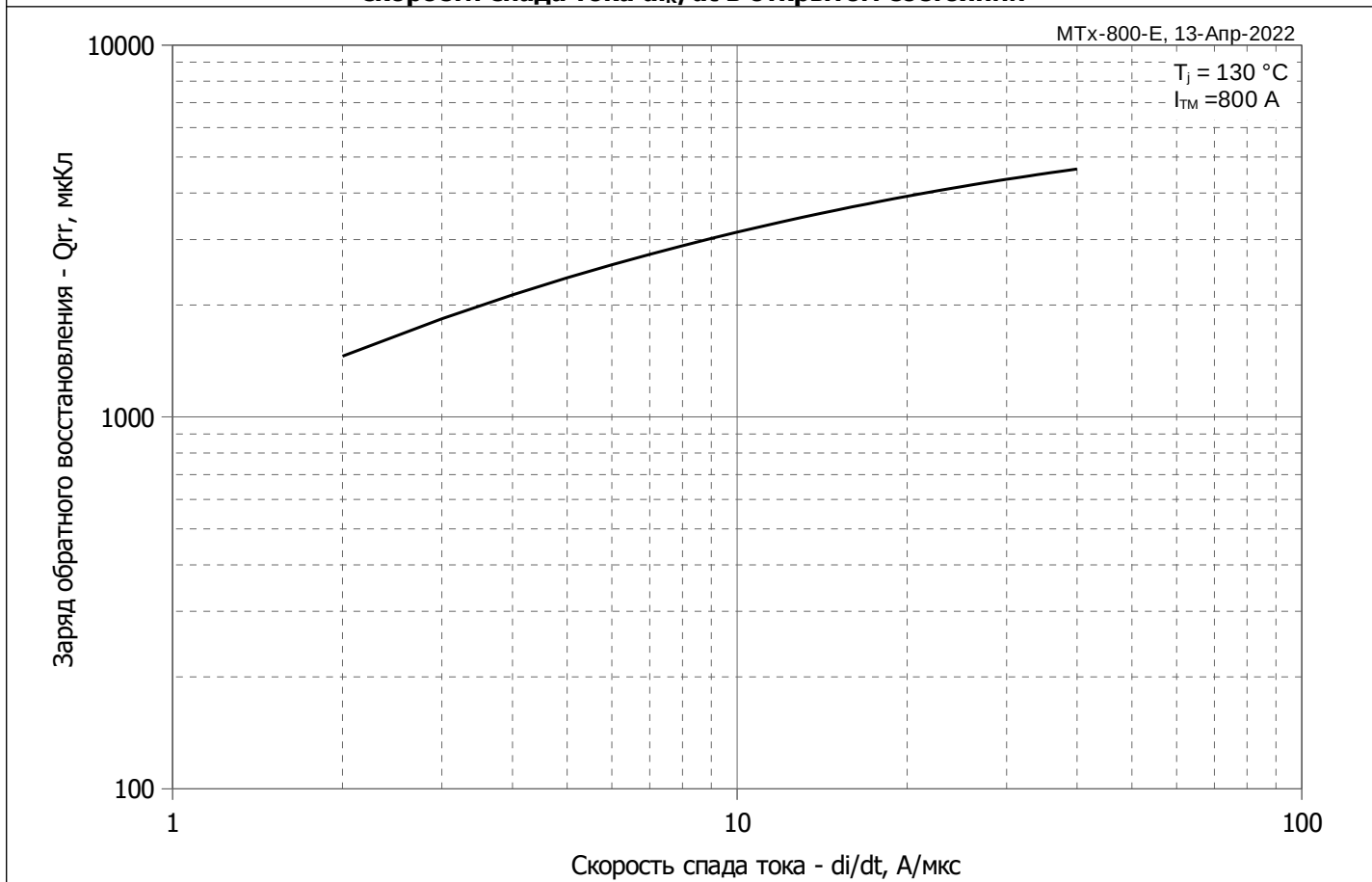
**Рис. 3 – Вольт – амперная характеристика цепи управления**



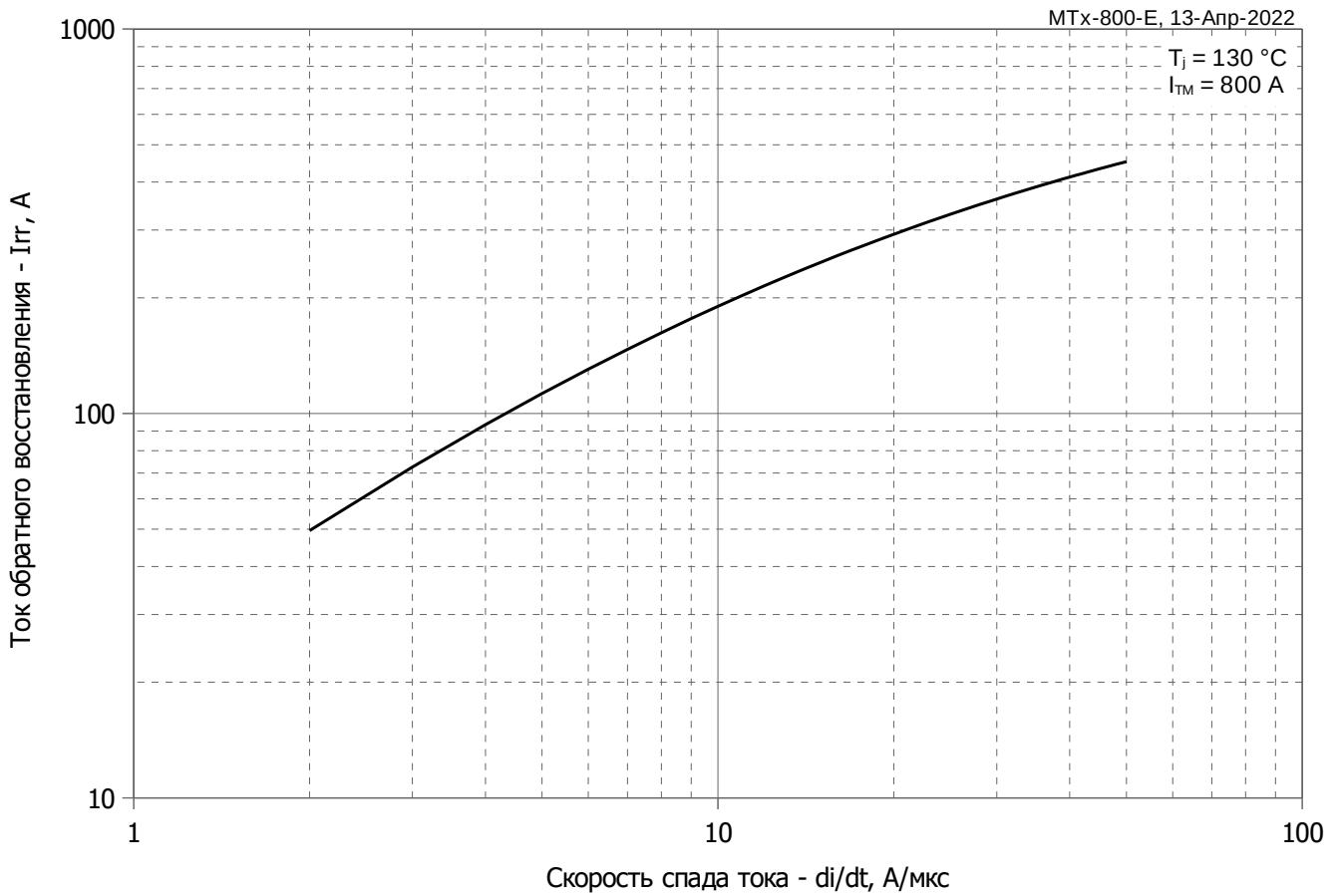
**Рис. 4 – Вольт – амперная характеристика цепи управления — Кривые мощности**



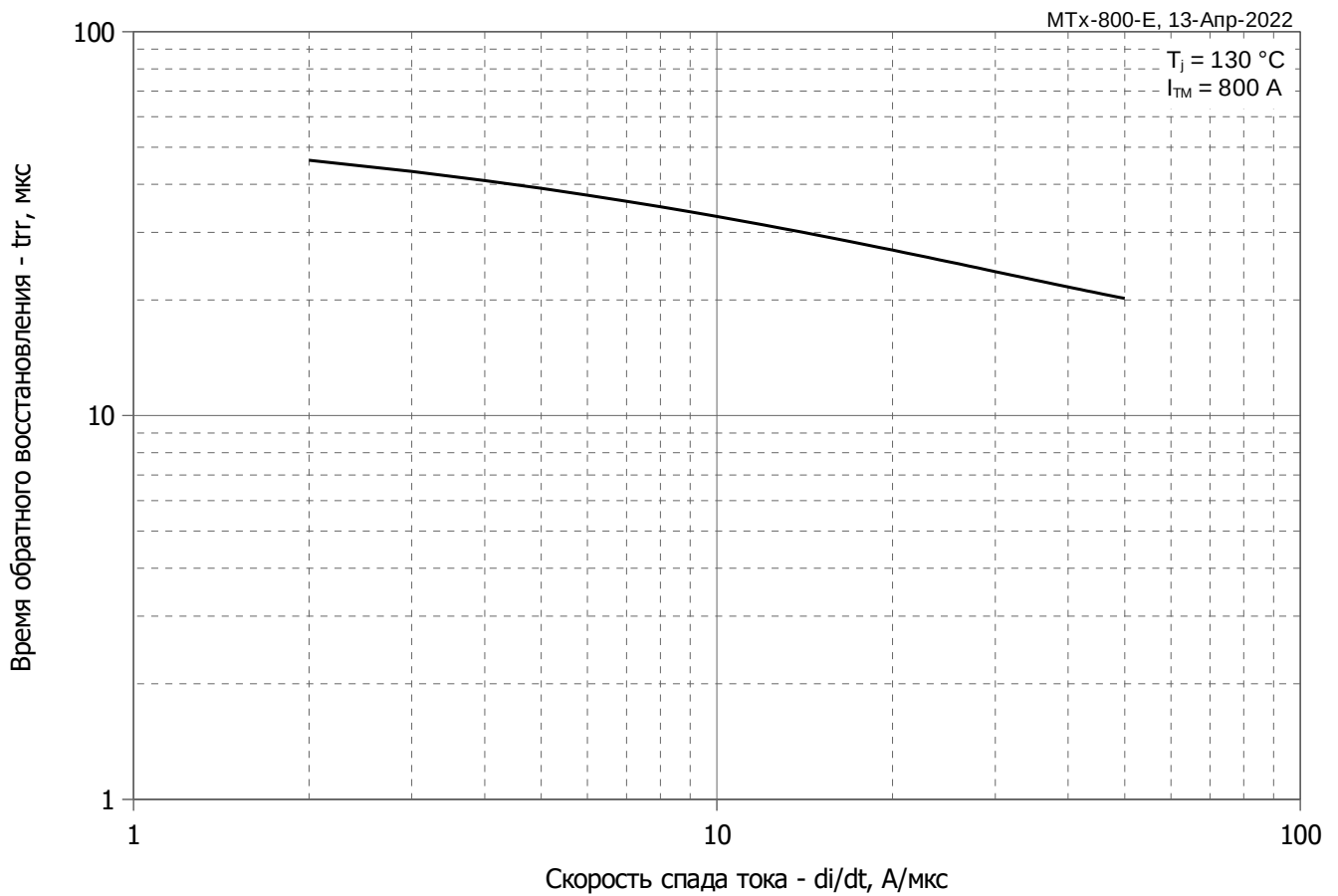
**Рис. 5 – Зависимость максимального интегрального заряда обратного восстановления  $Q_{rr-i}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**



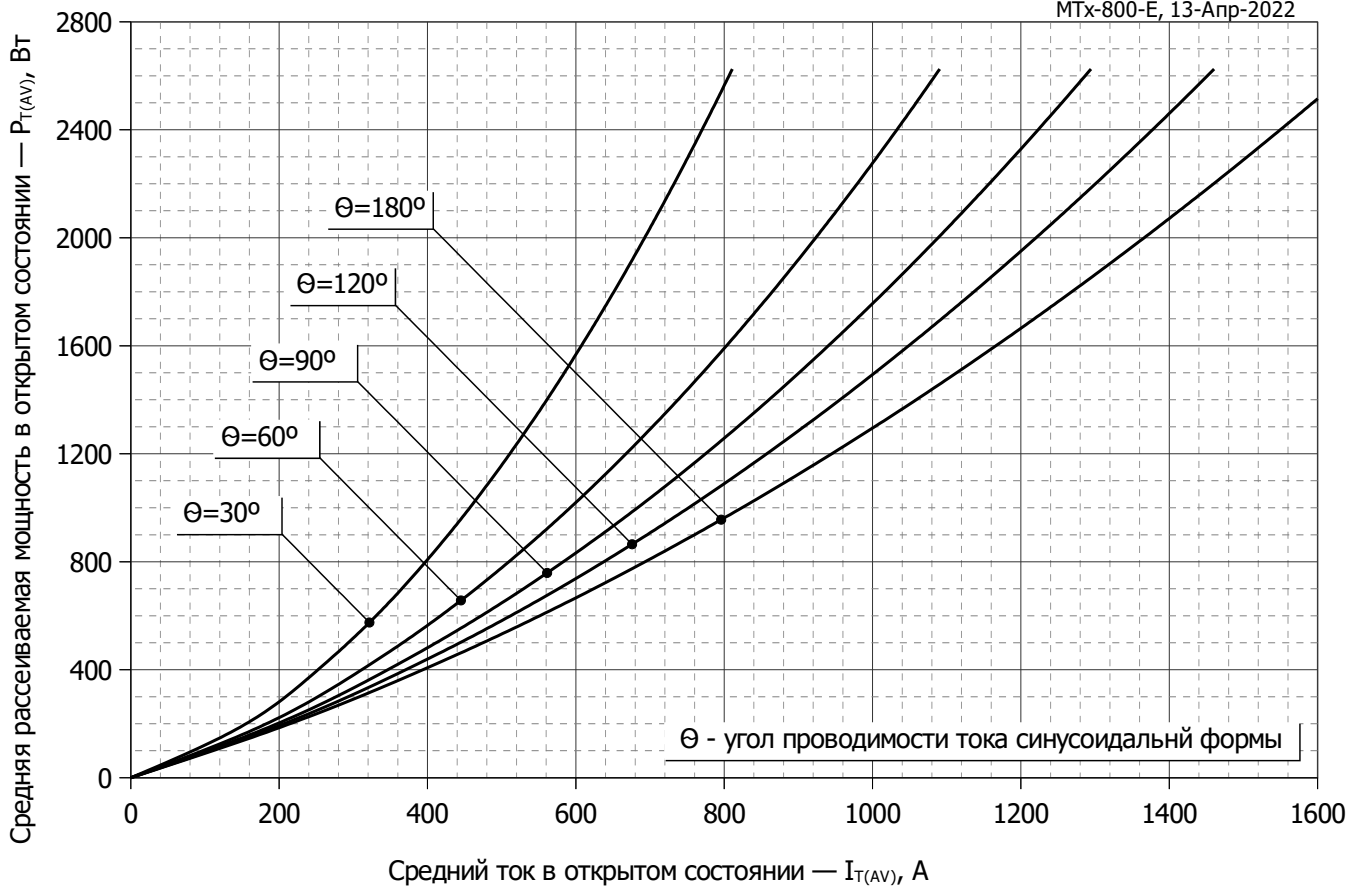
**Рис. 6 – Зависимость максимального заряда обратного восстановления  $Q_{rr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**



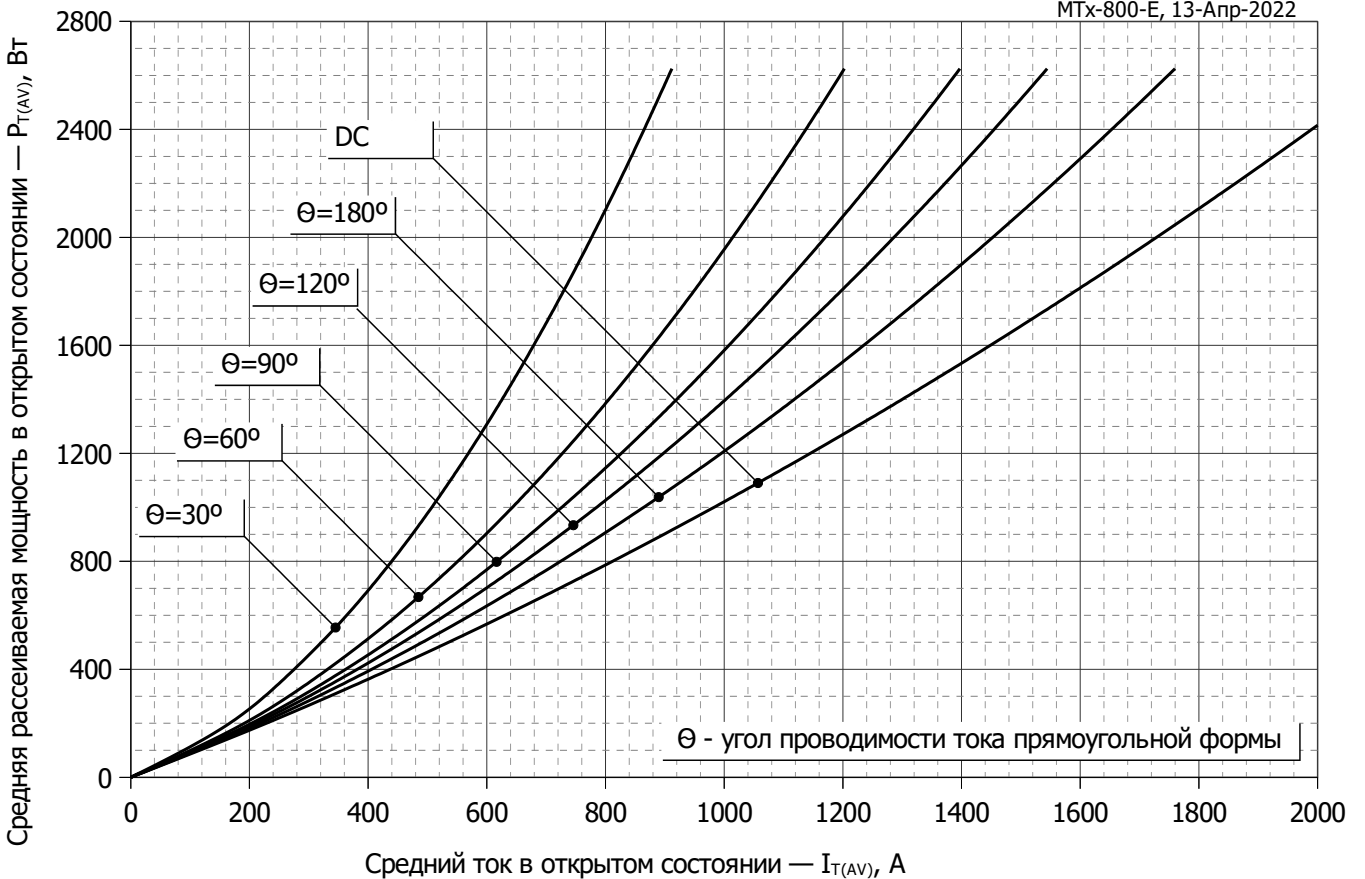
**Рис. 7 – Зависимость максимального тока обратного восстановления  $I_{tr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**



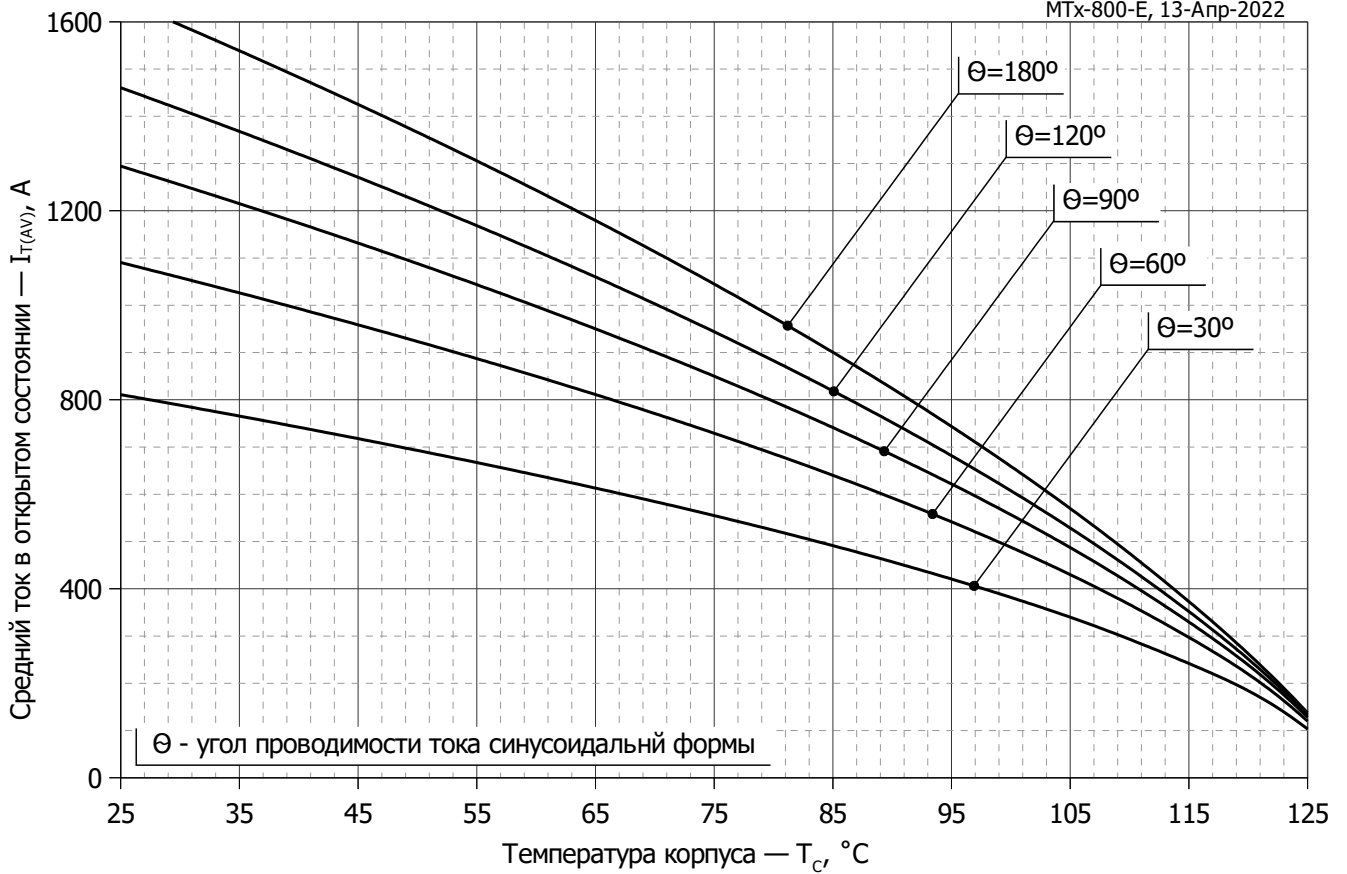
**Рис. 8 - Зависимость максимального времени обратного восстановления  $t_{tr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**



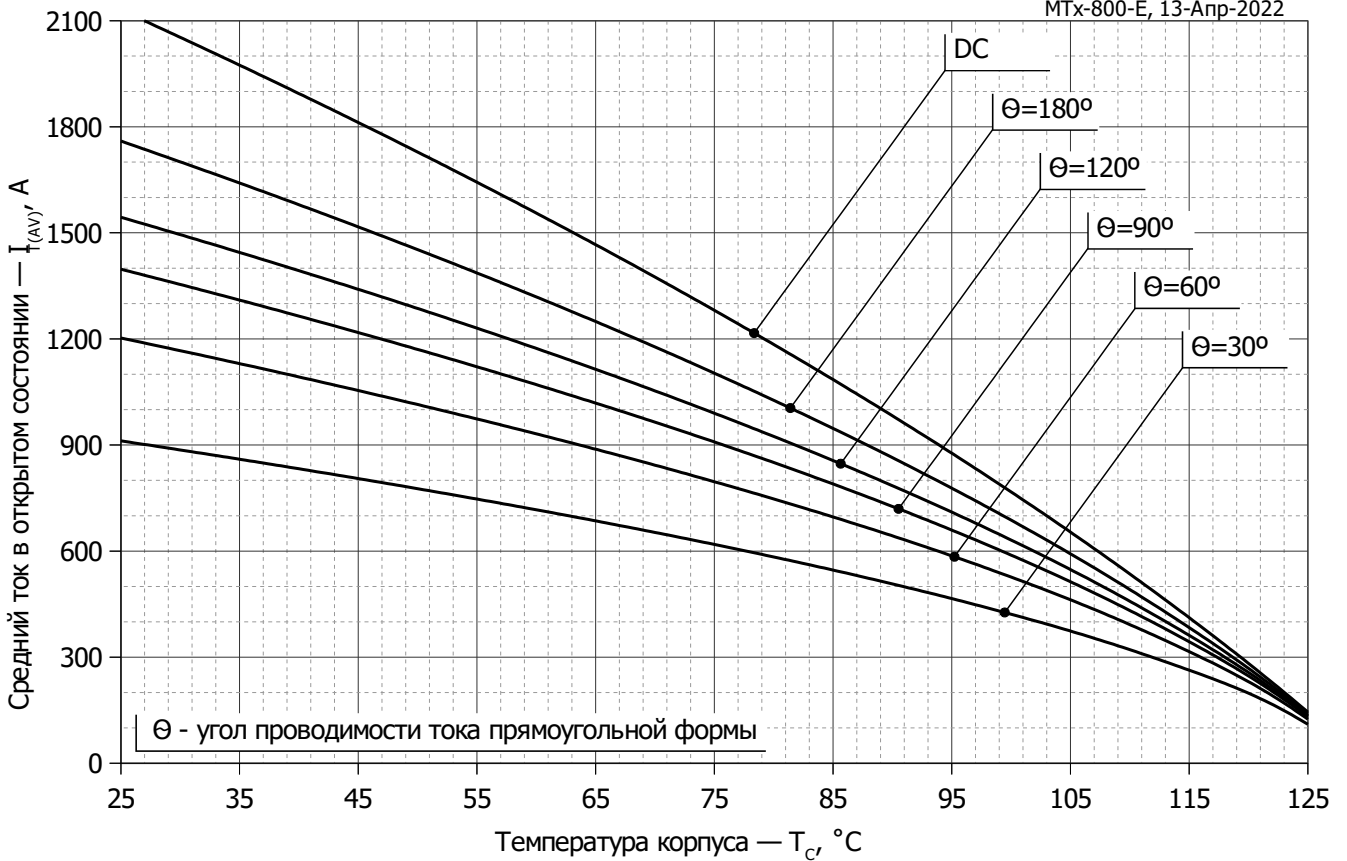
**Рис. 9 - Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  синусоидальной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



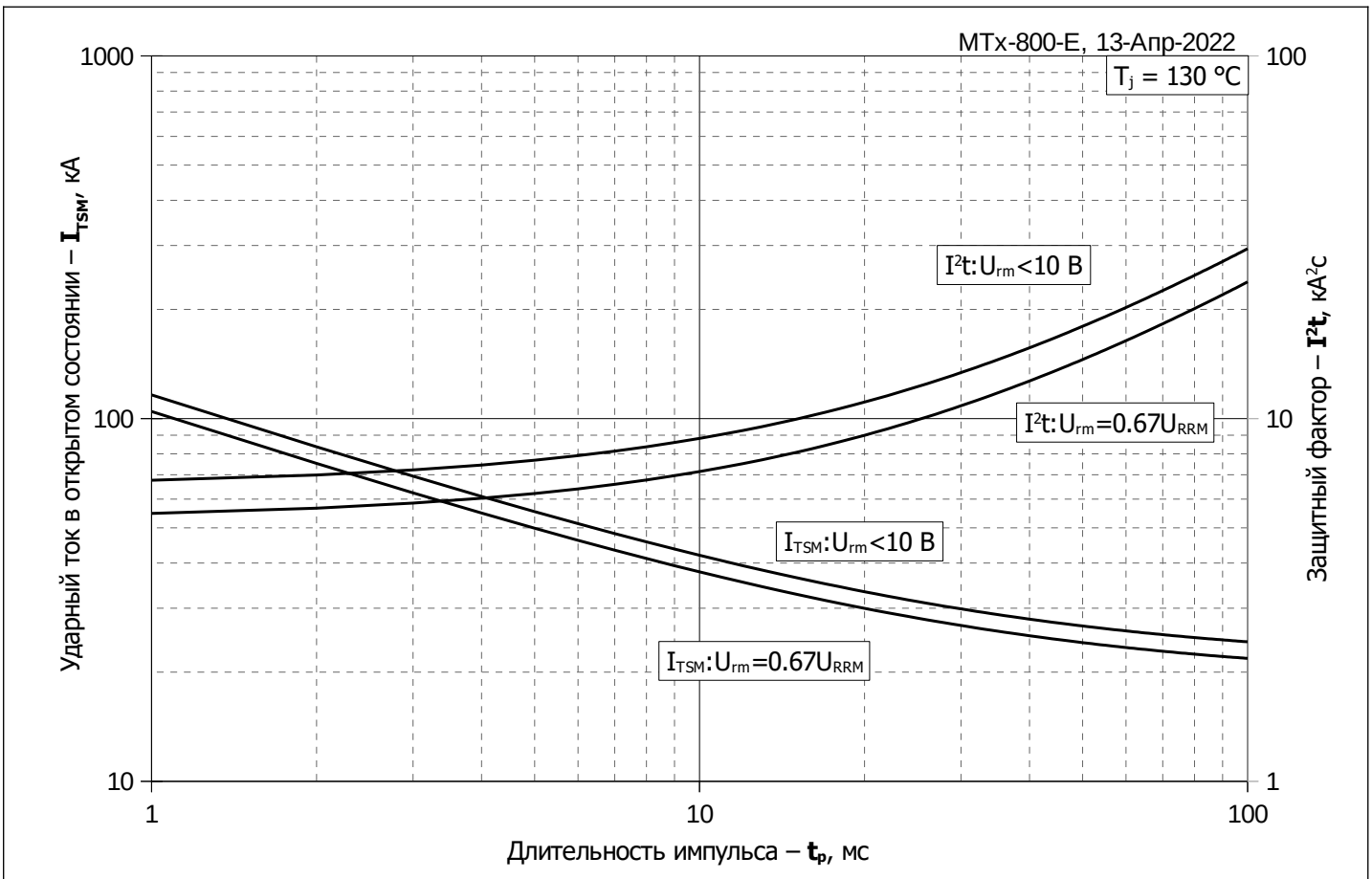
**Рис. 10 – Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  прямоугольной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



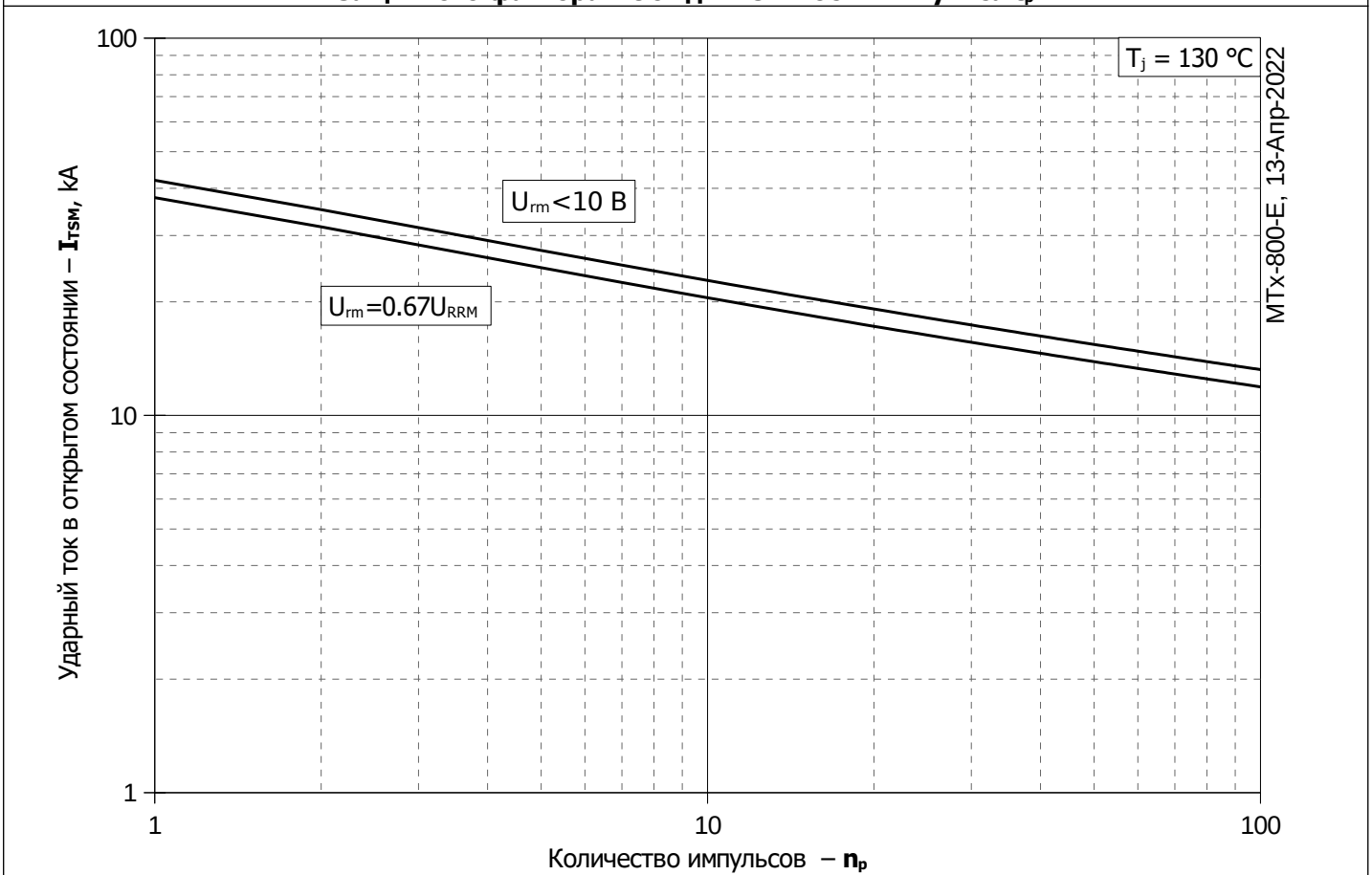
**Рис. 11 – Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_C$  для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



**Рис. 12 - Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_C$  для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



**Рис. 13 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{\text{FSM}}$  и защитного фактора  $I^2t$  от длительности импульса  $t_p$**



**Рис. 14 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{\text{FSM}}$  от количества импульсов  $n_p$**